FEATURES

∗0.28-inch (7.0-mm) DIGIT HEIGHT.
∗CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS.
∗LOW POWER REQUIREMENT.
∗EXCELLENT CHARACTERS APPEARANCE.
∗HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST.
∗WIDE VIEWING ANGLE.
∗SOLID STATE RELIABILITY.
∗CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.

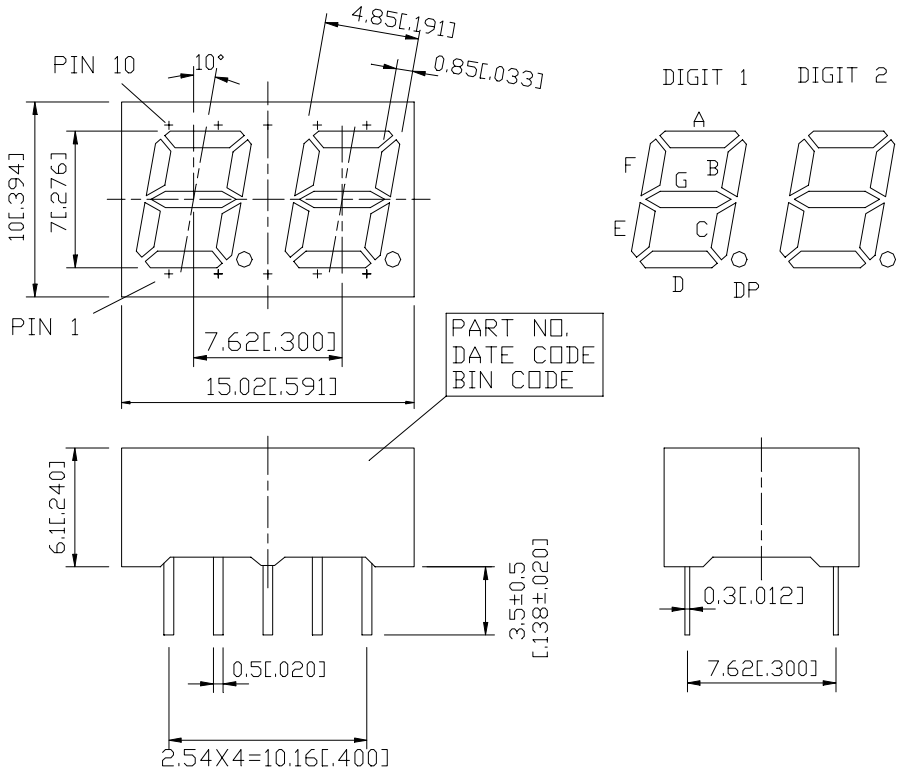
DESCRIPTION

The LTD-2601B is a 0.28-inch (7.0-mm) digit height dual digit seven-segment display. This device utilizes blue LED chips, which are made from GaN on a SiC substrate, and has a gray face and white segments.

DEVICE

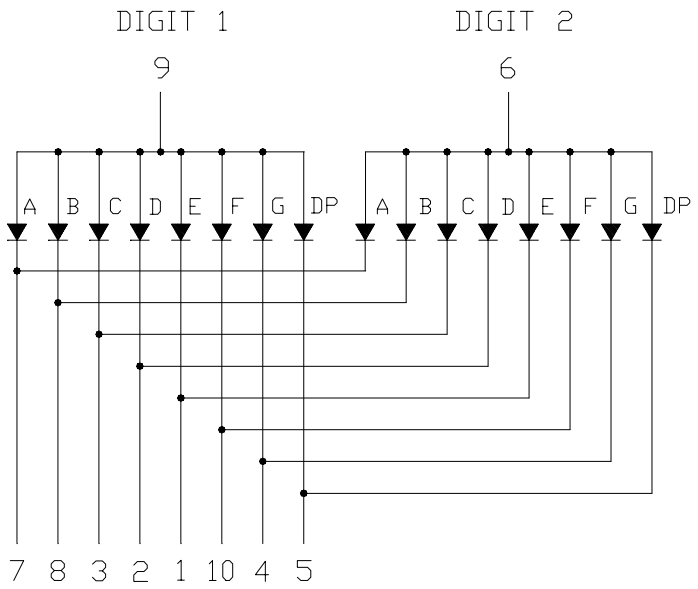
PART NO.	DESCRIPTION
BLUE	Duplex Common Anode
LTD-2601B	Rt. Hand Decimal

PACKAGE DIMENSIONS



NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25 mm (0.01“) unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM



PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	CATHODE E
2	CATHODE D
3	CATHODE C
4	CATHODE G
5	CATHODE DP
6	COMMON ANODE (DIGIT 2)
7	CATHODE A
8	CATHODE B
9	COMMON ANODE (DIGIT 1)
10	CATHODE F

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	65	mW
Peak Forward Current Per Segment (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	60	mA
Continuous Forward Current Per Segment Derating Linear From 25℃ Per Segment	15 0.2	mA mA/℃
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35℃ to +85℃	
Storage Temperature Range	-35℃ to +85℃	
Solder Temperature: max 260℃ for max 3sec at 1.6mm below seating plane.		

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I_V	1000	3000		μcd	I_F=10mA
Peak Emission Wavelength	λp		428		nm	I_F=20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		65		nm	I_F=20mA
Dominant Wavelength	λd		466		nm	I_F=20mA
Forward Voltage Per Segment	V_F		3.8	4.5	V	I_F=20mA
Reverse Current Per Segment	I_R			100	μA	V_R=5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I_V-m			2:1		I_F=10mA

Note: Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

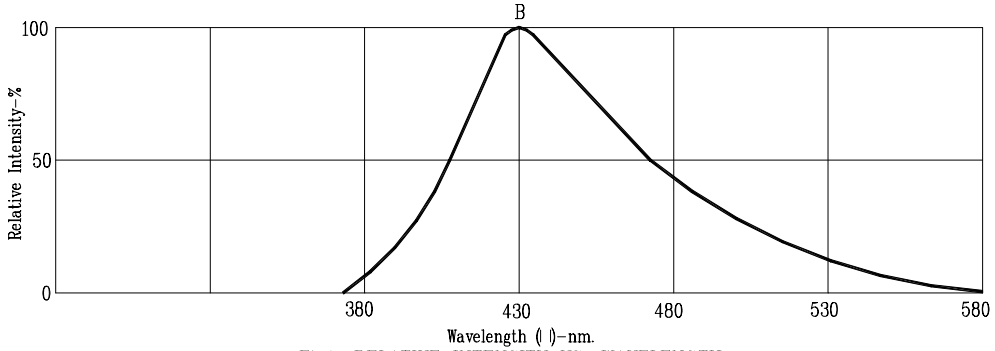


Fig1. RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

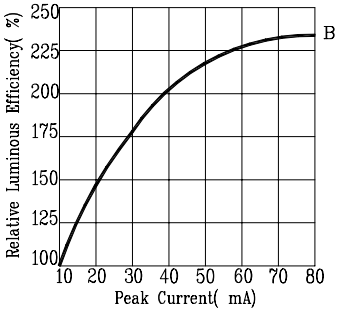


Fig2. RELATIVE LUMINOUS EFFICIENCY VS. PEAK FORWARD CURRENT (250us pulse width; 2ms period)

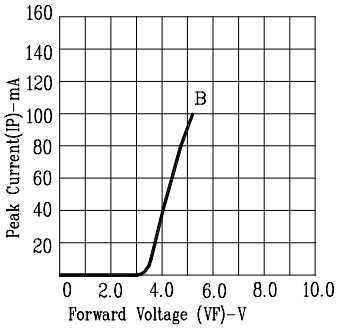


Fig3. FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

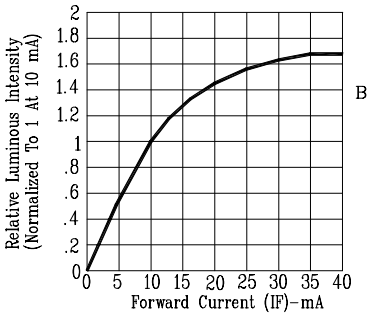


Fig4. RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

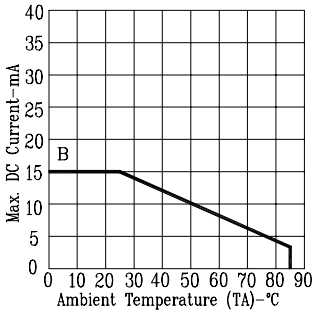


Fig5. MAX. ALLOWABLE DC CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE.

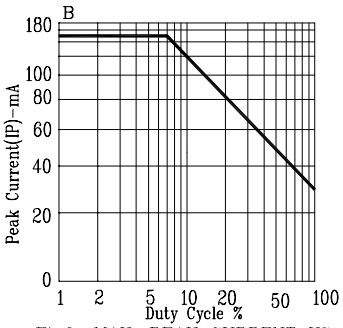


Fig6. MAX. PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE % (REFRESH RATE 1KHz)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9